

デバイス材料工学 (MA3e19L1)

担当教員：近藤 高志 教授，内田 建 教授

対象：第3学年	単位数：2.0	バイオ	環境・基盤	ナノ・機能
		標準	標準	限定
実施時期：A2ターム 月曜日 2時限 木曜日 2時限		場所：41号講義室		

講義目的

半導体デバイスの動作原理の基本を理解し、材料技術の果たす役割と意義を理解する。電子デバイスについては、pn接合とCMOSを中心とした電子デバイスの動作原理、近年のAIをはじめとする新しい計算手法を実現する上で、材料の果たす役割とについて講義する。光デバイスについては、発光ダイオード・半導体レーザとフォトダイオード・太陽電池の動作原理、用いられる半導体材料の特性、特に化合物半導体の特徴とその応用について講義する。

講義項目

半導体物性の基礎とpn接合
MOS表面ポテンシャルとC-V特性の理解
MOSFETの動作原理
AI向けハードウェアと新規材料技術
半導体における光学遷移

化合物半導体とバンドエンジニアリング
発光ダイオード(LED)
半導体レーザ(LD)
半導体受光素子と太陽光発電

理解すべき事項

バンドギャップと有効質量
多数キャリア・少数キャリアの区別
表面ポテンシャルの物理的意味
トランジスタ動作とCMOS応用
AI向けハードウェアの構成要素
直接遷移と間接遷移，電子・正孔再結合，自然放出と誘導放出
III-V族化合物半導体の結晶構造と電子構造
pn接合，擬フェルミ準位，量子効率
反転分布，レーザ発振，ダブルヘテロ構造
フォトダイオード，APD，太陽電池

関連する講義

事前履修：材料量子力学、材料統計力学、固体物性学、半導体材料学、薄膜プロセス工学
並行履修：
事後履修：応用ナノデバイス材料学

参考書(テキスト)：タウア・ニン，”最新VLSIの基礎”(丸善)，S. M. Sze，“Physics of Semiconductor Devices”，Saleh/Teich，“Fundamentals of Photonics, Third ed.”(Wiley)

参考書(演習書)：

講義ノートのリック先：(光デバイス) <http://www.castle.t.u-tokyo.ac.jp/lecture/>

成績評価：試験

備考